光励起分子気体レーザー用キャパシ ティブメッシュ反射鏡の研究*

Capacitive-mesh Output Coupler for Optically Pumped Molecular Gas Laser

綱 脇	岛 恵	章 ¹⁾	田	中	和	男 ²⁾	小	林	正	光3)	
Yoshiaki	TSUNA	WAKI	Kazu	ωΊ	ANA	KA	Masami	tsu	KOB.	AYASH	١I

Synopsis

Dual beam modulated far-infrared methyl alcohol gas laser interferometer has been constructed for use in high density tokamak and capacitive-mesh couplers have been developed since mode quality of far-infrared laser is of great importance for low divergence beam properties.

In this study, the properties of the mesh were represented with equivalent circuit as shown by Ulrich. The transmittance obtained in the far infrared region was not sufficiently in agreement with that calculated from the equivalent circuit. It became, however, clear that capacitive-mesh coupler was suited as output mirror for optically pumped far infrared lasers.

1. 緒 言

将来のエネルギー源として嘱望される核融合プラズマは,現在トカマク型で約10¹⁴cm⁻³の電子密度 が得られるようになっている。このプラズマ密度の測定手段の一つとして,プラズマ中を通過する電磁 波の位相シフト量を測定する方法が有力なものとして,現在多くの研究がなされている。^{1)~5)}

このとき,使用される電磁波として遠赤外レーザーが用いられ,核融合プラズマの軸上での最大電子 密度が、 10^{13} 、 10^{14} 、 10^{15} cm⁻³に対しては、それぞれ 337μ mHCNレーザー、 118.8μ mCH₃OHレザー、 41.7μ mCH₃OHレザーが適していることが知られている。⁶⁾ これらのことを考慮して、我々も、Fig.1 に示すような2光束変調型光励起遠赤外レーザー干渉計を名古屋大学プラズマ研究所共同研究として 大阪大学において設計試作し、双子型光励起遠赤外CH₃OHレーザーの研究を行なってきた。⁷⁾

今この光励起遠赤外 CH₃OHレーザー光を有効に発振させるためには、 CH₃OHレーザー共振器を構成するカップリング鏡が、CO₂励起レーザー光の波長 λ_P に対しては高い反射率をもち、遠赤外光 λ_{FIR} に対しては、適度の透過率と出来る限り低い吸収係数をもつことが必要であり、しかも、直径が数cmの プラズマを診断するためには、出来る限り広い面からの発振した 遠赤外光を取り出すようにすべきで あり、また回折広がりを出来るだけ小さくする必要がある。これら条件を満たす機構に Fig.2 に示す

^{*}昭和55年1月14日原稿受理

^{1), 2), 3)} 大阪産業大学教養部



Fig.1 2光束変調型遠赤外CH₃OH レーザー干渉計

ようなキャパシティブメッシュを 遠赤外レーザー取り出し側のカップリング鏡として 用いる方法が考



えられる。このようにキャパシティブメッ シュを使用することは,次のような利点が あげられよう。

- 1) 機構が比較的簡単
- ファブリーペローエタロンと異なり
 基盤の厚みをそれ程厳密に調整する必要はない。
- メッシュの格子定数gを任意に選ぶ ことにより、適度の透過率を λFIR に対 して得ることができ、しかもそれより も短い波長の λP に対して十分高い反 射率を得ることができる。

4) メッシュの基盤に水晶を用いることにより、出力側から洩れ出る λ を吸収し、特別なフィルタ ーを用いなくてもよい。

本研究においては、上記特徴を有するキャパシティブメッシュを試作し、遠赤外領域での透過率特性 を調べ、CH₃OH遠赤外レーザー共振器に応用し、その問題点を調べた。

2. 金属メッシュの特性

2.1 マクスウェルの式から考えた透過率・反射率8)

誘電率および透磁率が夫々 ε , μ の場を E_x , H_y の電場および磁場ベクトルをもった平面電磁波が Z方向に進むとき,

$$\frac{\partial \mathbf{E}_{\mathbf{x}}}{\partial \mathbf{Z}} = -\mu \mathbf{j} \omega \mathbf{H}_{\mathbf{y}} \frac{\partial \mathbf{H}_{\mathbf{y}}}{\partial \mathbf{Z}} = -\varepsilon \mathbf{j} \omega \mathbf{E}_{\mathbf{x}}$$
(1)

と表わされる。(1)を解けばA, Bを定数として

$$E_{x} = Ae^{j\omega t - \gamma_{0}z} + Be^{j\omega t + \gamma_{0}z}$$

$$H_{y} = \frac{1}{Z_{0}} (Ae^{j\omega t - \gamma_{0}z} - Be^{j\omega t + \gamma_{0}z})$$

$$(2)$$

$$(2)$$

$$(3)$$

$$(3)$$

$$(4) \cup Z_{0} = \sqrt{\mu/\epsilon} \quad \gamma_{0} = j\omega\sqrt{\epsilon\mu}$$

となる。Fig.3 のような異なった誘電体の境界面では, Iの領域において、

> $\left. \begin{array}{c} E_{x1} = E_i e^{-jk_1 z} + E_r e^{jk_1 z} \\ H_{v1} = (1/Z_1) \left(E_i e^{-jk_1 z} - E_r e^{jk_1 z} \right) \\ K_1 = \omega \sqrt{\mu_1 \varepsilon_1} \quad Z_1 = \sqrt{\mu_1 / \varepsilon_1} \end{array} \right\}$ (3)

媒質Ⅱの領域において

$$E_{x_{2}} = E_{t} e^{-jk_{2}z} H_{y_{2}} = (1/Z_{2})E_{t} e^{-jk_{2}z} K_{2} = \omega \sqrt{\mu_{2}\varepsilon_{2}}, Z_{2} = \sqrt{\mu_{2}/\varepsilon_{2}}$$

$$(4)$$

(E2 U2) $\bigotimes_{H_{i}=\sum_{l}}^{\bigotimes} E_{i}$ $H_{i}=\sum_{l}^{E_{i}} E_{i}$ $H_{r}=\sum_{l}^{E_{r}}$ $H_{t}=\sum_{l}^{E_{t}}$ (TT)

(ɛ, u,)

境界条件として

 $E_{x1} |_{z=0} = E_{x2} |_{z=0}$ (5) $H_{y1}|_{z=0} = H_{y2}|_{z=0}$

を用いると

$$\begin{array}{c} E_{i} + E_{r} = E_{t} \\ (1/Z_{1})(E_{i} - E_{r}) = (1/Z_{2})E_{t} \end{array} \right\} \tag{6}$$

電圧反射率(又は振幅反射率)をΓ,電圧透過率(又は振幅透過率)をτとおくと(6)より

$$\Gamma = \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{r}}}{\mathbf{E}_{\mathrm{l}}} = \frac{\mathbf{Z}_{2} - \mathbf{Z}_{1}}{\mathbf{Z}_{2} + \mathbf{Z}_{1}}$$

$$\tau = \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{t}}}{\mathbf{E}_{\mathrm{l}}} = \frac{\mathbf{Z}_{2}}{\mathbf{Z}_{2} + \mathbf{Z}_{1}}$$

$$\mathbf{I} + \Gamma = \tau$$

$$(7)$$

が得られる。エネルギー反射率(R),エネルギー透過率(T)としては

$$R = |\Gamma|^{2} = \left| \frac{Z_{2} - Z_{1}}{Z_{2} + Z_{1}} \right|^{2}$$

$$T = |\tau|^{2} = \left| \frac{2Z_{2}}{Z_{2} + Z_{1}} \right|^{2}$$

$$|\Gamma|^{2} + |\tau|^{2} = 1$$
(8)

空間に金属メッシュがある場合,メッシュの反射率 $\Gamma(\omega)$,透過率 $\tau(\omega)$ は,(i)厚さが無視できる程

- 46 -

うすい,(ii) 電気伝導度が無限大であるという条件のもとで求めると,(7),(8) と同様な関係式が求まる。

2.2 等価回路の立場から考えた透過率・反射率9)

2.1節で述べたことは伝送線モデルを使って表現することができる。

Fig.4 のように,インピーダンス,キャパシタンスが 連続的に分布した伝送線を考える。電圧および電流の x 方向への変化はそれぞれ

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -ZI = -\mathbf{j}\omega LI$$

$$\left. \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = -YV = -\mathbf{j}\omega \mathbf{c}V \right\}$$
(9)



Fig.4 L, Cが連続的に分布する伝送線

(1)と(9)より

 $V \leftrightarrow \mathbf{E}_{\mathbf{x}} \quad \mathbf{I} \leftrightarrow \mathbf{H}_{\mathbf{y}} \quad \mathbf{L} \leftrightarrow \mu \quad \mathbf{C} \leftrightarrow \varepsilon$

と対応させることができる。(9)を解けば

$$\left. \begin{array}{l} V = A e^{j\omega t - \gamma_0 x} - B e^{j\omega t + \gamma_0 x} \\ I = (1/Z_0) (A e^{j\omega t - \gamma_0 x} - B e^{j\omega t + \gamma_0 x}) \\ \exists U \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad \gamma_0 = j\omega \sqrt{LC} \end{array} \right\}$$
(10)

二つの異なったインピーダンス Z₁, Z₂を持った伝送線が接続されている場合,その接続点における 反射率,透過率は(7)を求めたと同様にして

$$\left. \begin{array}{c} \Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \\ \tau = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \\ R = \mid \Gamma \mid^2, \quad T = \mid \tau \mid^2 \end{array} \right\}$$
(11)

と表わされる。

誘電体の内部に厚さを無視できるようなメッシュがあ る場合 (Fig. 5 (a)) その透過回路は Fig. 5 (b) のように 表わされ,その反射率,透過率は(12)のようになる。但し, Zはメッシュのインピーダンス, Z' はFig. 5 (c) のよう に考えた場合の 3-3'点からの右のインピーダンスを表 わす。





 Fig.5
 誘電体内に十分に薄

 いメッシュが存在す
 るときの等価回路

2.3 メッシュの透過率・反射率

インピーダンスが1であるような空間内にメッシュが存在するとき、 $g \ll \lambda$ の波長領域での、厚さが 無視できるようなインダクティブメッシュの等価回路は、Fig. 6(a)のように表わせる。さらに $g \approx \lambda$ 付近も考慮に入れその厚さが無視できないようなとき、

Fig. 6 (b)のような等価回路で表現できる。¹⁰⁾ その振幅反 射率,振幅透過率は(12)より





インダクティブメッシュとコンプリメンタリーな特性を示すキャパシティブメッシュにおいては, Fig. 7 (a), (b)に示されるように, それぞれ厚さが無視で きる場合と無視できない場合の等価回路が表現される。

$$\left. \begin{array}{l} \Gamma_{\rm c} = \frac{2Z}{1+2Z} \\ \tau_{\rm c} = \frac{-1}{1+2Z} \\ Z = \frac{R}{2} + j \frac{1}{2} \left(\omega L - \frac{1}{\omega c} \right) \end{array} \right\}$$
(14)

として表わされ,(13)と比較すると $\Gamma_1 = \tau_c, \ \Gamma_c = \tau_1$ であることがわかる。



っことがわかる。 F さらに Ulrich¹⁰⁾は,実験的にそれらの等価回路と実

際のメッシュ定数(g, a)とを関連づけ次のような関係式を得ている。

$$R = \frac{1}{1 + Z_0^2 \Omega^2}$$

$$T = \frac{Z_0^2 \Omega^2}{1 + Z_0^2 \Omega^2}$$

$$Z_0 = 1/2 \ell n \operatorname{cosec}(a\pi/g)$$

$$\Omega = \omega/\omega_0 - \omega_0/\omega$$

$$\omega_0 = 1 - 0.27(a/g)$$

$$\omega = g/\lambda$$
(15)

3. 結果および考察

キャパシティブメッシュは直径40mm,厚さ1.5mm,Z-cut 水晶板上にAl蒸着を施したものを用いた。 蒸着膜厚は干渉顕微鏡観察より3000Å以上と考えられる。但し、メッシュ定数g,2aは Table1 に示 すとおりである。Fig.8 は、No.2のキャパシティブメッシュに、6328Å He-Ne レザーを照射し、その 後方 L=1442mm の位置で観測した回折像をトレースした図である。等間隔に並ぶ回折像点がgの周期

- 48 --

Table 1 試作したキャパシティブ メッシュの定数

	mesh const.				
No.	2a	g			
1	13 µm	76 μm			
2	$17 \ \mu m$	76 μm			
3	21 µm	76 μm			

によるものであり, x, y方向の濃淡の繰り返し が 2a によるものである。それらの間隔は, 理論 的に求まる(16)で表わされる回折像強度の周期とよ く一致する。

$$I(\mathbf{x}) = \left(\frac{\sin\frac{\pi g}{\lambda L}(2N+1)\mathbf{x}}{\sin\left(\frac{\pi g}{\lambda L}\mathbf{x}\right)}\right)^2 \frac{2\pi a}{\lambda L} \mathbf{x} \left(\frac{\sin\frac{2\pi a}{\lambda L}\mathbf{x}}{\frac{2\pi a}{\lambda L}\mathbf{x}}\right)^2$$
(16)

他の2つのキャパシティブメッシュについても同 様な回折像が得られた。以上のことからこれら試 作されたキャパシティブメッシュは Table1のメ ッシュ定数を正確に満たしていることがわかる。





Fig.8 M2のキャパシティブメッシュの回折像



マリスのるキャパシティン メッシュの反射率の 2a 依存性

Fig.9 は、(15)を用いて求めた吸収のないときの のキャパシティブメッシュの透過率を示す。いず れの場合においても、そのカットオフ周波数は、 g 値近傍の λ =76 μ m であり、波長と共にその透 過率が大きくなるのが見られる。また 2a が大きくなるとそれらの透過率は増大する。Fig. 10は、CH₃ OHレーザーの波長 118.8 μ m と 170.6 μ m に対する吸収のないときの反射率を、2aの関数として示した ものである。従来の研究では、反射率がほぼ 85% のときレーザー発振が認められており²⁾、この計算 結果では、波長 118.8 μ m に対しては全てのメッシュで、波長 170.6 μ m に対しては \mathbb{N} 1のメッシュの みで発振が期待される。

Fig.11 は、大阪大学大型遠赤外分光器¹¹⁾を用いて、試作したキャパシティブメッシュの透過測定 した結果を示す。Fig.9 の計算値と大きく異なり、 №1 のメッシュ以外はそのカットオフ特性は余り



Fig.11 試作したキャパシティブメッシュの透過率

ることにより、そのカットオフ特性がよくなることが期待される。

Fig.12 は、№3のキャパシティブメッシュを、Fig.1 の CH₃OHレーザー共振器の出力部に取りつ けて、118.8µm 線を発振させたときの、共振器長に対する出力信号を図示したものである。図に示す



ように、約10WのCO2レーザーで励 起したとき,ほぼ共鳴励起の場合, 約3.9MHzの半値全幅が得られ、そ の際の出力は2~3mWであった。 またポンプオフセットが負の場合, 非対称ダブレットが現われた。しか しこのときのダブレットの強度の大 小関係が,理論とは逆になっている。 これは恐らく, EH11 モードが, 両 方の平面鏡の平行度のずれや、励起 CO2 レーザー光束のパターンの影響 のため、なめらかでなく、またGolay 検知器が 30mm^Øの光束の一部を受 けていたとも考えられる。これらの ことが原因して同調曲線が乱されて 観測されたものであろう。なおNo.3 のメッシュを用いた場合,170.6µm

の弱いレーザー発振も同時に観測された。他方No.1のメッシュを用いた場合、118.8 μ m は観測されず、170.6 μ m のみが発振、No.2の場合は、いずれの波長のレーザー光も発振はしなかった。しかし、遠赤 外レーザー発振は、励起光である CO₂ レーザーの出力に大きく依存するため、今後さらに、キャパシティブメッシュの最適反射率と共に、 CO₂ レーザー出力についても検討していく必要があると考えられる。

よくなく,また全てのメッシュについて 150µm 付近に幅広い強い吸収が見られ る。この吸吸バンドは,基盤に用いた水 晶板による吸収のみでは説明され得ず, 蒸着に用いた Aℓ 材料内に含まれる不純 物による影響も今後調べていく必要があ ろう。また理論から求める電磁波のメッ シュへの浸入深さよりも,十分に厚いと 考えられる蒸着膜の厚さ(3000Å)では まだ不十分で,さらに厚い蒸着膜厚にす 以上,本研究において,キャパシティブメッシュの光学特性と理論との比較を十分検討するには至ら なかったが,光励起型遠赤外レーザーのカップリング鏡として,十分に使用できることが明らかになっ た。しかし,更に効率よく高い出力の遠赤外レーザーを得るには,(i)より大きな出力の CO₂ レーザ ーを用い,(ii)キャパシティブメッシュの Al 蒸着膜の厚さをコントロールし,(iii) 問題となる遠赤 外レーザー光の波長のところでの,キャパシティブメッシュの反射率を測定することにより,その最 適条件を見出すことが必要である。従って,今後さらに,この重要なキャパシティブメッシュの最適化 を検討していく予定である。

最後に本研究を遂行するにあたり, 多大なご助力をいただきました大阪大学工学部 応用物理学教室 山中正宣博士に深く感謝の意を表します。

参 考 文 献

- 1) D. V'eron : Opt. Comm. 10 (1974) 95
- 2) S. M. Wolfe, K. J. Button, J. Waldman and D. R. Cohn : Appl. Opt. 15 (1976) 2645
- K. J. Button and S. M. Wolfe : Far Infrared/Submillimeter Waves Technology/Applications, 105 (1977) 72
- 4) S. M. Wolfe and P.A. Pribyl : Bull. Amer. Phys. Soc. 22 (1977) 1193
- 5) K. J. Button : "Infrared and Millimeter Waves" Vol. 2, Academic Press, New York (1979)
- 6) 山中正宜:「干渉計測振動除去に関する研究」 日本原子力研究所委託調査報告書(1980年2月)
- M. Yamanaka, Y. Takeda, S. Tanigawa, A. Nishizawa, N. Noda, M. Takai, M. Shimobayashi,
 Y. Hayashi, T. Koizumi, K. Nagasaka, S. Okajima, Y. Tsunawaki, A. Nagashima and J. Fujita
 : IPPJ, Institute of Plasma Physics, Nagoya Univ., 1979
- 8) 吉永 弘他:「応用光学概論」 第2章 金原出版
- 9) 熊 谷 三 郎:「電気回路交流現象理論」 第15,16章
- 10) R. Ulrich : Infrared Phys., 7 (1967) 37
- H. Yoshinaga, S. Fujita, S. Minami, A. Mitsuishi, R. A. Oetzen and Y. Yamada : J. Opt. Soc. Amer., 48 (1958) 315